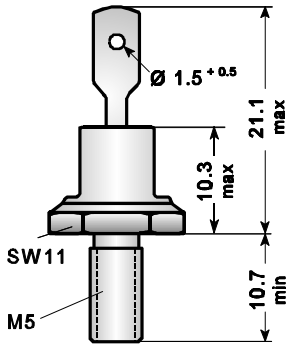


**Silicon-Power Rectifiers**

**Silizium-Leistungs-Gleichrichter**



Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom	12 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Metal case – Metallgehäuse	DO-4
Weight approx. – Gewicht ca.	5.5 g
Recommended mounting torque Empfohlenes Anzugsdrehmoment	18 ± 10% lb.in. 2 ± 10% Nm

Standard: Cathode to stud / am Gewinde  
 Index R: Anode to stud / am Gewinde (e.g. 1N 1199 A/R)

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
1N 1199 A PBY 271	50	60
1N 1200 A PBY 272	100	120
1N 1202 A PBY 273	200	240
1N 1204 A PBY 274	400	480
1N 1206 A PBY 275	600	720
1N 3671 PBY 276	800	1000
1N 3673 PBY 277	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	12 A <sup>1)</sup>
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	$I_{FRM}$	40 A <sup>1)</sup>
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	240 A <sup>2</sup> s
Peak fwd. half sine-wave surge current, superimposed on rated load	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$f = 60$ Hz	$I_{FSM}$ 240 A
Stoßstrom für eine Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$f = 50$ Hz	$I_{FSM}$ 220 A

<sup>1)</sup> Valid, if the temp. of the stud is kept to 100°C – Gültig, wenn die Temp. am Gewinde auf 100°C gehalten wird

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	$T_j$	- 65...+175°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_s$	- 65...+175°C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 30\text{ A}$	$V_F$	< 1.5 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 100 $\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to stud Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			$R_{thC}$	< 2 K/W